

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ОД
А.А.Панфилов

« 03 » 09 _____ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы кристаллографии
(наименование дисциплины)

Направление подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Программа подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат
(бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная, сокращенная)

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
5	5/180	36	18	-	81	экзамен (45)
Итого	5/180	36	18	-	81	экзамен (45)

Владимир 2018 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Основы кристаллографии» студентами направления подготовки «Нанотехнологии и микросистемная техника» предполагает получение систематизированного представления о закономерностях атомного строения кристаллов, их симметрии, структурных типах кристаллических веществ, знание элементов и операций симметрии кристаллов, основных структурных типов кристаллических веществ, овладение навыками кристаллографических расчетов. Дисциплина является теоретической основой процесса технологического получения наноструктур твердых тел, а также методологической базой для моделирования процессов образования нанокластеров.

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ кристаллографии и кристаллофизики, раскрытие связи между структурой и свойствами кристаллических тел.

Задачи дисциплины:

- знакомство с теорией представления групп симметрии;
- изучение элементов и операций симметрии кристаллов;
- получение практических навыков математического и компьютерного моделирования процессов кристаллообразования и формирования нанокластеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы кристаллографии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению «Нанотехнологии и микросистемная техника».

Изучение дисциплины предполагает наличие фундаментальных знаний, которые формируются у студентов при изучении предшествующих дисциплин базовой части: «Физика», «Математика», а также дисциплин вариативной части: «Введение в нанотехнологию», «Квантовая и статистическая физика»

Знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины, могут быть применены при изучении других специальных дисциплин по направлению подготовки, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

- 1) способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов (ОПК-1);
- 2) способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
- 3) способность проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий (ПК-1);
- 4) готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) **Знать:** адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); основные понятия и методы теории уравнений математической физики уметь ис-

пользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-1); современное состояние и перспективы развития наноиндустрии (ПК-3).

2) Уметь: представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); формализовать задачу, строить алгоритм её решения, проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий, использовать основные приёмы обработки и представления экспериментальных данных в своей профессиональной деятельности; применять математические методы для построения математических моделей и исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-1); осуществлять самостоятельный поиск и анализ необходимой для профессиональной деятельности информации, выделять основное содержание из общего массива сведений (ПК-3).

3) Владеть: способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); навыками решения дифференциальных уравнений математической физики на уровне, позволяющем анализировать математические модели прикладных задач; навыками работы в средах программирования; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, методами информационных технологий с соблюдением требований информационной безопасности (ПК-1); навыками эффективного поиска во всемирной сети Интернет информации; навыками отбора и конспективного представления полученной информации в соответствующей презентационной форме (ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Симметрия кристаллов.	5	1-6	12	-	6	-	-	20	-	10/56%	Рейтинг-контроль №1
2	Структура кристаллов.	5	7-12	12	-	6	-	-	21	-	6/33%	Рейтинг-контроль №2
3	Свойства кристаллов.	5	13-15	6	-	3	-	-	10	-	4/44%	Рейтинг-контроль №3
4	Моделирование роста кристаллических структур.	5	16-18	6	-	3	-	-	30	-	7/78%	
Всего		5	18	36	-	18	-	-	81	-	27/50%	Экзамен, 45ч.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕКЦИИ

Раздел 1. Симметрия кристаллов.

- 1.1. Способы образования твердых тел. Свойства кристаллических структур. 2ч
- 1.2. Точечные элементы симметрии кристаллов. 2ч.
- 1.3. 32 класса точечной симметрии кристаллов. 2ч.
- 1.4. Инверсионные и винтовые оси 2ч.
- 1.5. 230 пространственных групп симметрии. 2ч.
- 1.6. Геометрия многогранников роста кристаллов. Простые формы кристаллов. 2ч.

Раздел 2. Структура кристаллов.

- 2.1. Кристаллическая решетка. Элементарная ячейка. 2ч.
- 2.2. Сингонии. Типы простых решеток (SC, BCC, FCC). 2ч.
- 2.3. 14 типов решеток Бравэ. Ячейки Вигнера-Зейтца. 2ч.
- 2.4. Кристаллографические индексы Миллера. Обратная решетка. 2ч.
- 2.5. Исследование кристаллической структуры. Дифракция Вульфа-Брэгга. 2ч.
- 2.6. Метод Лауэ. Метод Дебая. 2ч.

Раздел 3. Свойства кристаллов.

- 3.1. Классификация кристаллов по типам связей. 2ч.
- 3.2. Тепловые свойства твердых тел. 2ч.
- 3.3. Анизотропия кристаллов. Жидкие кристаллы. 2ч.

Раздел 4. Моделирование роста кристаллических структур.

- 4.1. Физические модели роста кристаллов. 2ч.
- 4.2. Метод дискретного моделирования. Упаковочное пространство. 2ч.
- 4.3. Квазикристаллы и их модели. 2ч.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

- Тема 1. Изоморфизм групп преобразований симметрии и групп перестановок. 2ч.
- Тема 2. Точечные операции симметрии (центр инверсии, поворотная ось, плоскость зеркального отражения). 2ч.
- Тема 3. Инверсионные и винтовые оси. 2ч.
- Тема 4. Простые решетки. Построение ячеек Вигнера-Зейтца. 2ч.
- Тема 5. Кристаллографические плоскости. 2ч.
- Тема 6. Геометрия многогранников роста. 2ч.
- Тема 7. Упаковочное пространство. Двумерная модель кристалла. 2ч.
- Тема 8. Дуальность графа и разбиения. Граф связности упаковки и его рост. 2ч.
- Тема 9. Квазикристаллы на последовательности Фибоначчи и разбиении Пенроуза. Построение предфракталов. 2ч.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках лекционного курса:

5.1. Активные и интерактивные формы обучения

С целью формирования и развития профессиональных навыков студентов в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой: (контрольные аудиторные работы, индивидуальные домашние работы).

5.2. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов включает закрепление теоретического материала при подготовке к выполнению индивидуальной домашней работы, к практическим занятиям. Основа самостоятельной работы - изучение литературы по рекомендованным источникам и конспекту лекций.

5.3. Мультимедийные технологии обучения

Некоторые из лекционных и практических занятий проводятся в виде презентаций в мультимедийной аудитории с использованием компьютерного проектора. Студентам предоставляется компьютерный курс лекций.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. Экзаменационные вопросы

1. Точечные элементы и операции симметрии.
2. Способы образования твердых тел. Особенности кристаллических структур.
3. Инверсионные и винтовые оси.
4. Геометрия многогранников роста кристаллов. Простые формы кристаллов.
5. Кристаллическая решетка. Элементарная ячейка.
6. Сингонии. Типы простых решеток (SC, BCC, FCC).
7. 14 типов решеток Бравэ. Ячейки Вигнера-Зейтца.
8. Кристаллографические плоскости. Индексы Миллера.
9. Обратная решетка.
10. Основы теории дифракции. Дифракция Вульфа-Брэгга.
11. Рентгеноструктурный анализ. Метод Лауэ. Метод Дебая.
12. Классификация кристаллов по типам связей.
13. Тепловые свойства твердых тел. Фононная модель тепловых колебаний.
14. Анизотропия кристаллов. Жидкие кристаллы.
15. Фотонные кристаллы.
16. Физические модели роста кристаллов.
17. Метод дискретного моделирования. Упаковочное пространство.
18. Квазикристаллы и их модели.
19. Конструктивные фракталы и предфракталы.

6.2. Вопросы рейтинг-контроля

Рейтинг-контроля №1

1. Точечные элементы и операции симметрии.
2. Изоморфизм групп преобразований симметрии и перестановок.
3. Определение всех преобразований симметрии у конечных объектов.
4. Инверсионные оси.
5. Винтовые оси.
6. Единичные направления в кристаллах
7. Многогранники роста кристаллов

Рейтинг-контроля №2

1. Элементарная ячейка и ее параметры.
2. Сингонии. Расчет простых решеток.
3. Решетки Бравэ.
4. Построение ячейки Вигнера-Зейтца.
5. Индексы Миллера.
6. Обратная решетка.
7. Дифракция Вульфа-Брэгга.
8. Рентгеноструктурный анализ.

Рейтинг-контроля №3

1. Типы связей в кристаллах.
2. Волны в одномерном одноатомном кристалле
3. Анизотропия свойств в кристаллах.
4. Жидкие кристаллы.
5. Фотонные кристаллы.
6. Модели роста кристаллов.
7. Конструкция упаковочного пространства.
8. Квазикристаллы и их моделирование.
9. Конструктивные фракталы и предфракталы.

6.3. Вопросы для контроля самостоятельной работы:

1. Стереографические проекции. Сетка Вульфа.
2. Структурные дефекты в кристаллах.
3. Теория плотнейших упаковок (Китайгородский).
4. Эпиморфизм и гомоморфизм групп.
5. Полиэдрический методы изображения кристаллических структур (метод Полинга – Белова).
6. Двойное лучепреломление и поляризация в кристалле.
7. Упаковки поликубов и полимино. Аппроксимация молекул поликубами.
8. Построение молекулярных полиэдров Вороного-Дирихле
9. Построение фрактала Мандельброта и Жулиа.
10. Фракталы Серпинского, Коха и Гаспера.
11. Параметризация разбиения Розы.
12. Банки структурных данных.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Основы геометрической кристаллографии: учебное пособие / Новоселов К.Л. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 73 с.
2. Кащенко, А. П. Физика твердого тела. Физика ядра. Ядерные реакции [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям и домашним заданиям по дисциплинам: «Взаимодействие излучения с веществом», «Теоретическая физика», «Физические свойства твердых тел» / А. П. Кащенко, Г. С. Строковский, С. И. Шарпов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 20 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55674.html>
3. Физика твердого тела: учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.— ISBN 978-5-369-00967-3.

Дополнительная литература:

1. Кристаллохимия. Краткий курс: учебник/ Урусов В.С., Ерёмин Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 256 с.
2. Физика конденсированного состояния вещества: учебное пособие/ Геринг Г.И., Панова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2008.— 106 с.
3. Физика твердого тела: учебное пособие / Корнилович А.А., Ознобихин В.И., Суханов И.И., Холявко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 71 с.

Интернет-ресурсы:

1. Кристаллографическая и кристаллохимическая база данных для минералов и их структурных аналогов «МИНКРИСТ»// Режим доступа: <http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/>
2. Кембриджский банк структурных данных// Режим доступа: http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/client_log_in.php?first_attempt=1

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные аудитории, оснащённые доской и переносным проектором для проведения занятий с применением компьютерных презентаций и демонстрационных роликов. Аудитории для проведения практических и лабораторных занятий, оснащённые современными персональными компьютерами, объединёнными в локальную вычислительную сеть и укомплектованными необходимым системным и прикладным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника.

Рабочую программу составил профессор каф. ФиПМ Рау В.Г.

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя) Нач.НИИКО-2 ФКП-«ГЛП Радуга» Антипов А.А.

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФиПМ

Протокол №1 от 03.09.2018 года

Заведующий кафедрой

С.М. Аракелян

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Протокол №1 от 03.09.2018 года

Заведующий кафедрой

С.М. Аракелян

(ФИО, подпись)

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____